

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 7 部門第 2 区分

【発行日】平成 26 年 10 月 2 日 (2014.10.2)

【公開番号】特開 2012-69927 (P2012-69927A)

【公開日】平成 24 年 4 月 5 日 (2012.4.5)

【年通号数】公開・登録公報 2012-014

【出願番号】特願 2011-180526 (P2011-180526)

【国際特許分類】

H 0 1 L 27/12 (2006.01)

H 0 1 L 21/02 (2006.01)

H 0 1 L 27/08 (2006.01)

【F I】

H 0 1 L 27/12 B

H 0 1 L 27/08 3 3 1 E

【手続補正書】

【提出日】平成 26 年 8 月 18 日 (2014.8.18)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

半導体基板に絶縁層を形成し、
前記絶縁層が形成された前記半導体基板にイオンを照射して脆化領域を形成し、
ベース基板を加熱して前記ベース基板表面に付着した水分量を低減し、加熱された前記ベース基板と、前記脆化領域が形成された前記半導体基板と、を対向して接触させて貼り合わせ、

貼り合わされた前記ベース基板と前記半導体基板とを加熱して、前記脆化領域において分離させ、前記ベース基板上に半導体層を形成する、ことを特徴とする S O I 基板の作製方法。

【請求項 2】

半導体基板に絶縁層を形成し、
前記絶縁層が形成された前記半導体基板にイオンを照射して脆化領域を形成し、
ベース基板を加熱した後冷却して前記ベース基板表面に付着した水分量を低減し、冷却された前記ベース基板と、前記脆化領域が形成された前記半導体基板と、を対向して接触させて貼り合わせ、

貼り合わされた前記ベース基板と前記半導体基板とを加熱して、前記脆化領域において分離させ、前記ベース基板上に半導体層を形成する、ことを特徴とする S O I 基板の作製方法。

【請求項 3】

前記ベース基板を加熱する際に、
前記ベース基板を 55 以上 95 以下に加熱する、請求項 1 又は 2 に記載の S O I 基板の作製方法。

【請求項 4】

前記ベース基板を加熱する際に、
前記ベース基板の加熱温度以上の温度の気体を吹きつけて加熱を行う、請求項 1 乃至 3 のいずれか一に記載の S O I 基板の作製方法。